



美国伦斯勒理工学院周达成教授到半导体所交流

文章来源: 半导体研究所

发布时间: 2012-12-21

【字号: 小 中 大】

12月18日,应集成中心何志研究员的邀请,美国伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute)功率电子系统中心RPI园区主任周达成教授来半导体所黄昆论坛作题为*Progress in High Voltage SiC and GaN Power Switching Devices*学术报告。

周达成是Rensselaer Polytechnic Institute(RPI)终身教授,从事功率半导体器件研究超过25年,在分离器件和智能开关器件研究领域享有盛誉。特别是在IIIIV族宽禁带材料(SiC和GaN)半导体器件的研究方面,开发出众多创新结构和器件,是这一领域的先驱者,并主持多项DAPRA, Army Collaborative Tech Alliance, ONR PEBB, SiC MURI项目。拥有17项国际专利,在国际权威学术杂志发表论文过百篇,在相关教科书中编写了八个技术章节。他在工业界和学术界具有相当的影响力。

此次报告的主要内容包括:新兴的宽禁带半导体SiC和GaN由于其自身材料特性的优势,特别适合于制备功率电子器件。现在基于SiC和GaN的新生代功率器件已经进入商业化。报告还介绍和展示应用于高压功率开关的SiC和GaN基整流器和晶体管的最新进展。报告中指出,与SiC功率器件相比,在多大的电压和功率范围内,GaN功率器件将会具有竞争力甚至明显的优势。

报告结束后,在座科研人员及研究生踊跃提问,并对他们各自感兴趣的内容与周达成教授进行了深入的交流。

打印本页

关闭本页